Week3

大家好,相信经过了前两周的学习,大家已经对Altium Designer的原理图库和PCB**封装库**有了一定的了解,而本周我们将学习驱动电路的**原理**和原理图的**绘制**。

全H桥电路驱动电机原理

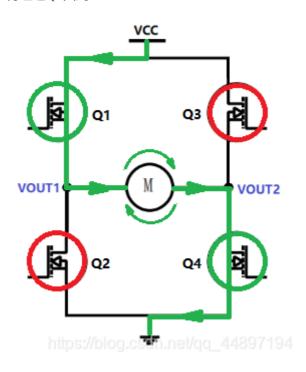
1、驱动电路的核心----H桥



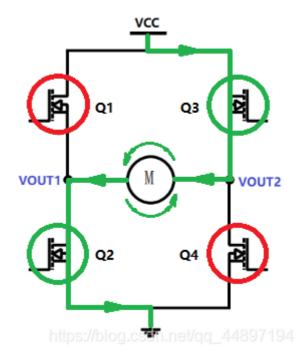
从上图可以看出,驱动电路是由四个NMOS管,一个motor,以及VCC,GND所构成的。驱动芯片可以控制栅极的电平高低,来控制NMOS管的开通与关闭,所以可以通过控制四个栅极的状态来控制MOS管的开通与关断,从而达到控制电机正反转的效果。通过调控不同PWM占空比,达到控制电机转速快慢的效果。这种驱动电路就叫做**H桥**

2、H桥的工作模式

电机正转时,芯片会控制Q1和Q4两个MOS管导通,Q2和Q3两个MOS管截止,这样电流就要通过Q1, 经过电机正侧M-A,M-B,再经过Q4回到GND



电机的反转,芯片会控制Q2和Q3两个MOS管导通,Q1和Q4两个MOS管截止,这样电流就要通过Q2, 经过电机负侧M-B, M-A, 在经过Q3回到GND



听起来很简单,但是在实际应用中,这样的电机驱动电路是不行的,电机是感性负载,在电路中电流不会发生突变。如果在断开电机两端所加的电压时,电机产生的**反向电动势很有可能损坏FET**。因此想让电机停下,除了断开供电,还要形成**一个续流的回路**,释放掉电机上的能量。会在MOS管的源极和漏极上并联一个寄生二极管,寄生二极管的方向和栅极方向相同,如下图:

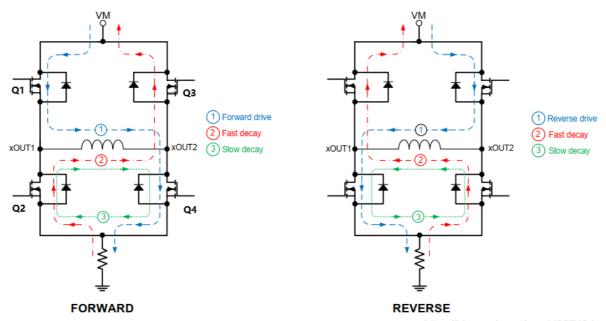
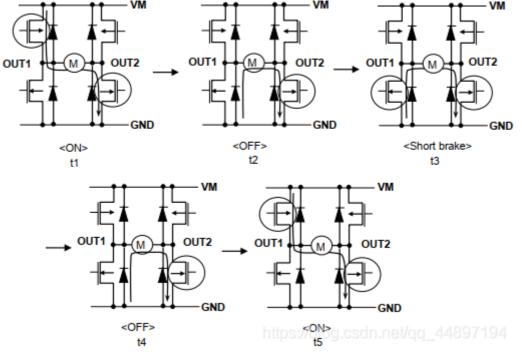


Figure 7. Drive and Decay Modes https://blog.csdr

3、死区控制

H桥中绝对不能出现同侧(左侧/右侧)的FET同时导通的情况,因为这样会导致电流不经过电机直接到地,形成短路!因此在状态切换时需要一步一步来,而集成H桥的芯片一般会在内部自动解决这个问题(利用**死区控制**),如下图所示:在正转和制动之间切换时,会有一个过渡状态(OFF)。



此处还需补充一个知识: MOS管的**高端与低端驱动**。简单来说,高端驱动即MOS管在负载的高电位一端;相反低端驱动即MOS管在负载的低电位一端。如上图所示: Q1、Q3为高端驱动,Q2、Q4为低端驱动。在H桥中也常常被称为上臂和下臂。

此外,如果对MOS管原理有所了解,则可看出,打开高端NMOS所需的栅极电压会比打开低端NMOS所需的栅极电压大很多(要高于驱动电源电压)。(因为开启需要条件Vgs>Vth,而高端MOS导通后的源极电位较高,几乎接近电源电压,此时如果栅极电压仍为电源电压,则又关断)

驱动电压越大, 转速越快; 电流越大, 扭矩越大

当扭矩<负载时,电机转速会下降,电流上升从而增大扭矩。当负载非常大,电机带不动从而停止转动时(堵转),电流达到最大值,此时需特别注意,很有可能烧坏电机驱动。

4、驱动芯片控制

由于驱动直流电机需要的电流很大,单片机I/O的**驱动能力**是远远达不到的,因此需要使用专用的电机驱动芯片,下面我所引用的资料在Document文件夹中的数据手册里都有

DRV8701E

1.引脚图

引脚名称	引脚 标号	引脚功能
VM	1	连接电机驱动电压5.9V-45V,使用0.1-μF陶瓷和额定VM的10-μF最小电容器旁路接地;根据驱动电流,可能需要额外的电容
GND	5 6 PPAD	与GND连接
VCP	2	将16V 1µF陶瓷电容器连接至VM
СРН	3	在CPH和CPL之间接一个0.1uF的X7R电容

引脚名称	引脚 标号	引脚功能
CPL	4	在CPH和CPL之间接一个0.1uF的X7R电容
DVDD	8	3.3V逻辑电源调节器;使用6.3V,1µF的陶瓷电容接地
AVDD	7	4.8V逻辑电源调节器;使用6.3V,1µF的陶瓷电容接地
nSleep	13	将逻辑拉低,使器件进入低功耗休眠模式,使用高阻态,内部下拉
Indive	12	施加在该引脚上的电阻值或电压设置门驱动电流
VREF	6	控制当前规律;施加0.3 V到之间的电压
nFAULT	9	故障条件下拉低逻辑;开漏输出需要外部上拉
SNSOUT	10	当驱动电流达到电流斩波阈值时,拉低逻辑; 开漏输出需要外部上拉
SO	11	该引脚上的电压等于SP电压乘以AV加上偏移量;在该引脚上放置不超过1 nF的电容
SN	20	通过电流检测电阻器连接至SP并接地
SP	21	通过电流检测电阻器连接到低侧FET源和SN
GH1、2	17、 24	连接到高侧MOS管栅极
GL1、2	19、 22	连接到低侧MOS管栅极
SH1、2	18、 23	连接到高侧源极和低侧漏级
IN1、2	15 14	输入PWM控制H桥

PS:由于MOS管导通后会产生一定的**饱和压降**(Vsat,不同芯片有较大差异,具体看手册),因此在选择驱动电压VM时,可以接近或比所用电机额定电压稍高。

2、芯片内部功能框图及外部电路设计



3、PWM栅极驱动模式



DRV8701中的栅极驱动器直接驱动N沟道MOSFET,从而驱动**电机电流**。高压侧栅极驱动由电荷泵提供,低压侧栅极驱动器电压由内部

栅极驱动器的监管。峰值驱动电流可通过IDRIVE引脚调节。

✔ 简单的来说

通过EN和PH输入的DIR和PWM控制信号,分别控制电机M旋转的方向和旋转的速度通过开关控制nSleep引脚,进而控制芯片的打开与关闭

至于详细的地方,如内部的逻辑控制或者详细的电路设计,都可以在数据手册里找到

原理图的绘制

在开始绘制原理图之前,我们必须要集齐以下两个条件

1、封装库

2、装配上封装库的原理图库

这方面的知识我们可以在**凡亿教育的AD20 19讲解视频**的P5~P15学到,其中包含了基本元器件和IC类器件的**原理图库绘制方法**(P5-P8),以及相应的**封装库的制作与寻找**(P14-P19),在我们拥有了属于自己的一套原理图库和封装库后,我们才能真正开始绘制我们的原理图

第6课 IC类元件模型的创建.mp4哔哩哔哩bilibili

PS: 老师讲的是真的很详细,听完他的课后,足以让一个从来没接触过Altium Designer的人掌握原理图和PCB绘制的能力,智能车硬件必看!

拥有了完整的库,我们开始着手准备原理图的绘制

所谓原理图,就是表示电路板上各器件之间连接原理的图表,是不同完整电路的组合,一个完善没有缺漏的原理图是画好PCB的基础。文字还是不如视频,建议大家直接观看视频的**P9-P13**完成学习

本周任务为绘制IR2104驱动电路,相应的讲解可以在下面的博客中找到

(14条消息) IR2104电机驱动zhuimeng ruili的博客-CSDN博客Ir2104驱动电路原理

焊接基础

实验室为大家准备好了焊接练习板和电阻电容,周末可以来体育中心B109上手电烙铁实操练习,使用时请务必注意安全